

Содержание

- XXV Международный симпозиум „Нанофизика и наноэлектроника“, Нижний Новгород, 9–12 марта 2021 г.

Мурсалимов Д.Ф., Михайлов А.В., Курдюбов А.С., Трифонов А.В., Игнатъев И.В.

Нетривиальная зависимость спектральных характеристик экситонов в квантовых ямах от мощности резонансного оптического возбуждения 963

Сибирев Н.В., Бердников Ю.С., Федоров В.В., Штром И.В., Большаков А.Д.

Точная модель самокаталитического роста нитевидных нанокристаллов Ga(As,P) 969

Алешкин В.Я., Дубинов А.А.

Влияние параметров квантовой ямы на спектр двумерных плазмонов в гетероструктурах HgTe/CdHgTe 973

Сушков А.А., Павлов Д.А., Андрианов А.И., Шенгуров В.Г., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Крюков Р.Н., Байдушь Н.В., Юрасов Д.В., Рыков А.В.

Сравнение гетероструктур $A^{III}B^V$, выращенных на платформах Ge/Si, Ge/SOI и GaAs 978

Хабибуллин Р.А., Маремьянин К.В., Пономарев Д.С., Галиев Р.Р., Зайцев А.А., Данилов А.И., Васильевский И.С., Виниченко А.Н., Клочков А.Н., Афоненко А.А., Ушаков Д.В., Морозов С.В., Гавриленко В.И.

Квантово-каскадный лазер на 3.3 ТГц на основе активного модуля из трех квантовых ям GaAs/AlGaAs с рабочей температурой > 120 К 989

● Обзоры

Михайлова М.П., Дмитриев А.П., Андреев И.А., Иванов Э.В., Куницына Е.В., Яковлев Ю.П.

Монополярное умножение горячих носителей заряда в полупроводниках $A^{III}B^V$ в сильном электрическом поле и бесшумные лавинные фотодиоды 995

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Ибрагимова С.И., Джабаров С.Г., Гусейнов Г.Г., Гулиева Х.М., Мирзаев М.Н., Алыев Ю.И.

Рентгеноструктурный и дифференциальный сканирующий калориметрический анализ $CuInZnSe_3$ 1011

● Электронные свойства полупроводников

Батырев А.С., Бисенгалиев Р.А., Горяева В.Н., Новиков Б.В., Сумьянова Е.В.

Эффекты ионной бомбардировки в спектрах краевой фотопроводимости и в вольт-амперных характеристиках кристаллов CdS 1015

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Середин П.В., Леньшин А.С., Khuder Abduljabbar Riyad, Голощапов Д.Л., Хараджиди М.А., Арсентьев И.Н., Касаткин И.А.

Свойства податливых подложек на основе пористого кремния, сформированных двухстадийным травлением 1021

Баграев Н.Т., Кукушкин С.А., Осипов А.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Хромов В.С.

Терагерцовое излучение из наноструктур карбида кремния 1027

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Рябцев С.В., Гхариб Д.А.А., Турищев С.Ю., Обвинцева Л.А., Шапошник А.В., Домашевская Э.П.

Структурные и газочувствительные характеристики тонких полупроводниковых пленок PdO различной толщины при детектировании озона 1034

Андрющенко Д.А., Ружевич М.С., Смирнов А.М., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Ремесник В.Г.

Оптические и структурные свойства эпитаксиальных слоев $Hg_{0.7}Cd_{0.3}Te$ 1040

Умирзаков Б.Е., Донаев С.Б., Ёркулов Р.М., Ашуров Р.Х., Ротштейн В.М.

Состав и морфология поверхности Si(111) с поверхностной пленкой SiO_2 разной толщины 1045

Маскаева Л.Н., Мостовщикова Е.В., Марков В.Ф., Воронин В.И., Поздин А.В., Селянин И.О., Михайлова А.И.

Химически осажденные пленки сульфида свинца, легированные кобальтом 1049

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Бурмистров Е.Р., Авакянц Л.П.

Исследование параметров двумерного электронного газа в квантовых ямах InGaN/GaN методом терагерцового плазмонного резонанса 1059

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Морозова Н.К., Мирошникова И.Н.

Система локализованных экситонов на кислородных комплексах в CdS 1068

Лазаренко А.А., Шубина К.Ю., Никитина Е.В., Пирогов Е.В., Мизеров А.М., Соболев М.С.

Влияние быстрого термического отжига на распределение атомов азота в GaAsN/GaAs 1077

● **Физика полупроводниковых приборов**

Бабичев А.В, Колодезный Е.С, Гладышев А.Г, Денисов Д.В, Вознюк Г.В, Митрофанов М.И, Михайлов Д.А, Чистяков Д.В, Курицын Д.И, Дюделев В.В, Слипченко С.О, Лютецкий А.В, Евтихий В.П, Карачинский Л.Я, Новиков И.И, Морозов С.В, Соколовский Г.С, Пихтин Н.А, Егоров А.Ю

Квантово-каскадный лазер с выводом излучения через текстурированный слой 1081

Малевская А.В., Ильинская Н.Д., Калюжный Н.А., Малевский Д.А., Задиранов Ю.М., Покровский П.В., Блохин А.А., Андреева А.В.

Исследование методов текстурирования светодиодов на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs 1086

Потапович Н.С., Нахимович М.В., Хвостиков В.П.

Фотоэлектрические преобразователи узкополосного излучения на основе гетероструктур InGaAsP/InP 1091